	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 S1XS213DE(单胞)	文件编号	XS-R-075
		版本号	18-A1-12
	肖特基二极管	页 码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

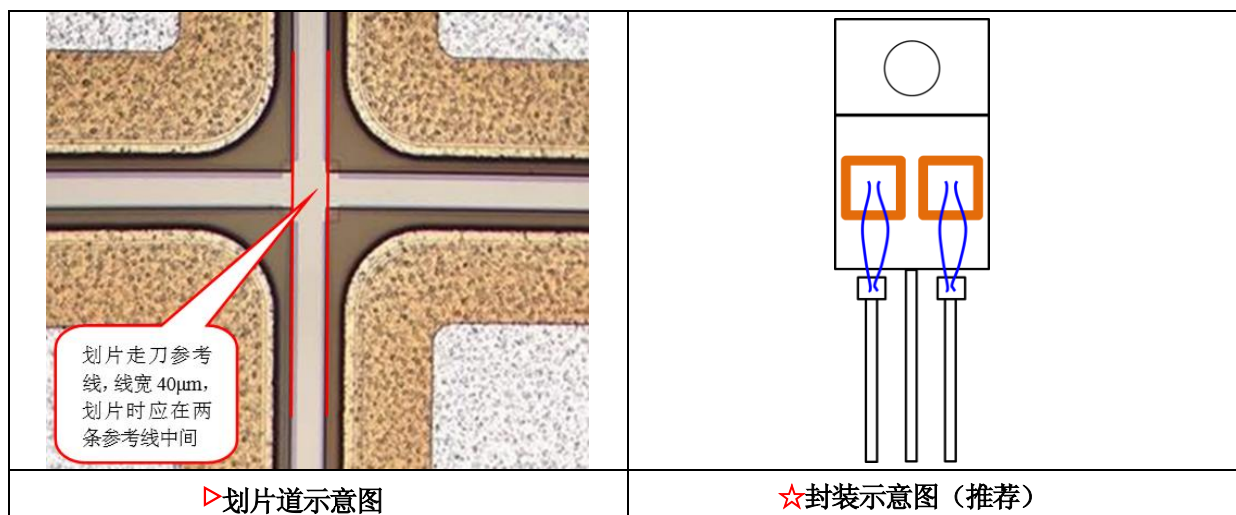
用 S1XS213DE 封装的成品管用于开关电源、高频逆变器、极性保护电路等各类电子电路上。

1.2 主要特点

- 高 ESD 能力
- 低功耗
- 高抗浪涌电流能力

2 芯片数据

	芯片示意图	芯片尺寸	2.1 mm×2.1 mm	
			82.68 mil×82.68 mil	
		芯片厚度 (μm) (推荐)	260 ± 20	
		▷划片道尺寸 (μm)	40	
		键合区面积 (μm ²)	正面	1700×1700
		正面电极 (阳极)	金属	铝
			厚度 (μm)	9.0 ± 1.5
		背面电极 (阴极) (推荐)	表层金属	银
		硅片直径 (mm)	φ 150	
		装片要求 (推荐)	焊料	
	键合要求 (推荐)	2 根 φ 380um 铝线 (单胞)		




江阴新顺微电子有限公司

地 址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：<http://www.xs-elec.com>

电 话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 S1XS213DE(单胞)	文件编号	XS-R-075
	肖特基二极管	版本号	18-A1-12
		页码	2/3

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

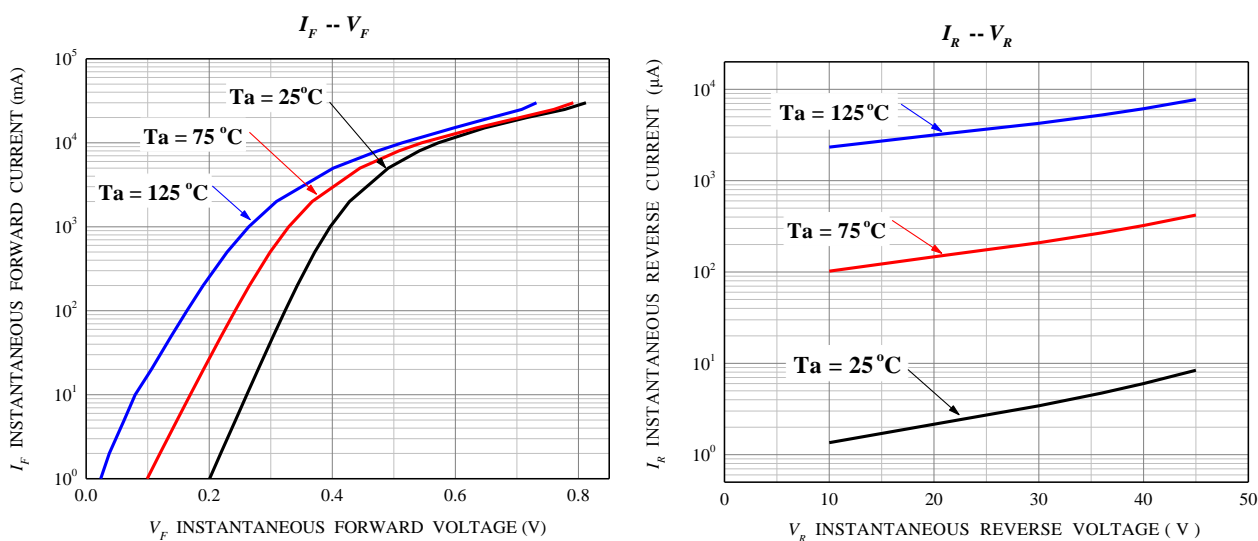
参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	45	V	推荐封装形式: TO-220 推荐成品型号: MBR1045 MBR2045CT
正向电流	$I_{F(AV)}$	10 (单胞)	A	
正向峰值浪涌电流@8.3ms	I_{FSM}	335	A	
反向浪涌电流	I_{RSM}	10	A	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R=0.1\text{ mA}$	45	—	—	V
反向电流	I_R	$V_R=45\text{V}$	—	9	50	μA
正向电压	V_{F1}	$I_{F1}=10\text{A}$	—	0.57	0.6	V
正向电压	V_{F2}	$I_{F2}=20\text{A}$	—	0.72	0.75	V
总电容	C_{tot}	$V_R=4\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	435	—	pF

3.3 典型特性曲线




江阴新顺微电子有限公司

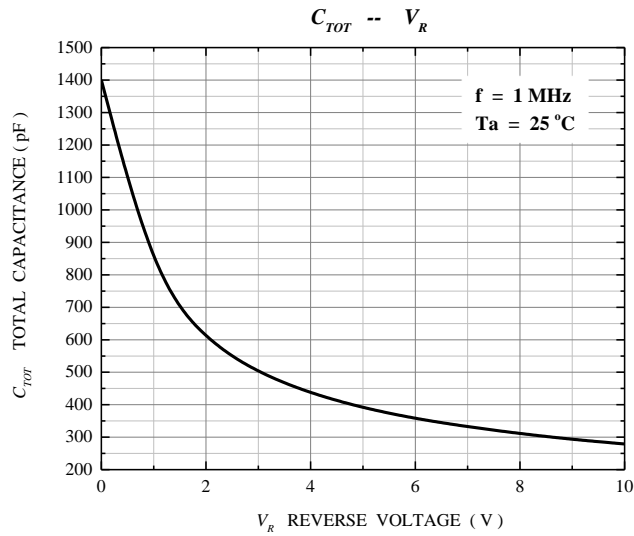
地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 S1XS213DE(单胞)	文件编号	XS-R-075
	肖特基二极管	版本号	18-A1-12
		页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网 址：<http://www.xs-elec.com>

电 话：(0510) 86851182

传 真：(0510) 86851532